

PCT

世界知的所有権機関
国際事務局
特許協力条約に基づいて公開された国際出願



<p>(51) 国際特許分類7 A61N 1/30</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/69514</p> <p>(43) 国際公開日 2000年11月23日(23.11.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP00/02967</p> <p>(22) 国際出願日 2000年5月10日(10.05.00)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平11/132676 1999年5月13日(13.05.99) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 久光製薬株式会社 (HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.)[JP/JP] 〒841-0017 佐賀県鳥栖市田代大官町408番地 Saga, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてののみ) 栗林 満(KURIBAYASHI, Mitsuru)[JP/JP] 前田浩幸(MAEDA, Hiroyuki)[JP/JP] 古賀伸裕(KOGA, Nobuhiro)[JP/JP] 肥後成人(HIGO, Naruhito)[JP/JP] 〒305-0856 茨城県つくば市観音台1丁目25番11号 久光製薬株式会社 筑波研究所内 Ibaraki, (JP)</p> <p>(74) 代理人 田中 清, 外(TANAKA, Kiyoshi et al.) 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番2号 恵比寿ガーデンテラス武蔵館709 Tokyo, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 AU, CA, US, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54)Title: ELECTRODE STRUCTURE FOR IONTOPHORESIS DEVICES AND METHOD OF PRODUCING THE SAME</p> <p>(54)発明の名称 イオントフォレーシス装置の電極構造体及びその製造方法</p> <div data-bbox="354 1241 1166 1604"> </div> <p>(57) Abstract</p> <p>An electrode structure for iontophoresis devices that is superior in economics, operability, stability and safety, and a method of producing the same. An electrode structure for iontophoresis devices has a backing that comprises base films (1) having forming portions, electrode layers (14, 15) on the anode and cathode sides formed to extend from the inner bottoms of the forming portions and through the outer peripheries, and insulation layers (3) each formed around the outer periphery of the forming portion. The forming portions of this backing have recesses, where electrically conductive layers (12, 13) on the anode and cathode sides are disposed. Covers (8) are provided for sealing these electrically conductive layers (12, 13) between them and the insulation layers (3). The back of each base film (1) is provided with a skin-applied adhesive sheet (10), and adhesive sheet liners (16) are disposed on the covers (8).</p>		

BEST AVAILABLE COPY

(57)要約

経済性、操作性、安定性および安全性に優れたイオントフォレーシス装置の電極構造体及びその製造方法を提供するものである。イオントフォレーシス装置の電極構造体は、成形部を有する基材フィルム(1)と、成形部の内底より外周部を通過して形成された陽極側及び陰極側電極層(14)、(15)と、成形部の外周部に形成された絶縁層3とを有するバックングを備える。このバックングの成形部はくぼみを有しており、ここに陽極側及び陰極側導電層(12)、(13)がそれぞれ配置される。これらの導電層(12)、(13)を絶縁層(3)との間でシールするためフタ材(8)が設けられる。基材フィルム(1)の背面には皮膚貼付用の粘着シート(10)が備えられ、フタ材(8)の上には粘着シート用ライナー(16)が設けられる。

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

AE	アラブ首長国連邦	DM	ドミニカ	KZ	カザフスタン	RU	ロシア
AG	アンティグア・バーブーダ	DZ	アルジェリア	LC	セントルシア	SD	スーダン
AL	アルバニア	EE	エストニア	LI	リヒテンシュタイン	SE	スウェーデン
AM	アルメニア	ES	スペイン	LK	スリ・ランカ	SG	シンガポール
AT	オーストリア	FI	フィンランド	LR	リベリア	SI	スロベニア
AU	オーストラリア	FR	フランス	LS	レソト	SK	スロヴァキア
AZ	アゼルバイジャン	GA	ガボン	LT	リトアニア	SL	シエラ・レオネ
BA	ボスニア・ヘルツェゴビナ	GB	英国	LU	ルクセンブルグ	SN	セネガル
BB	バルバドス	GD	グレナダ	LV	ラトヴィア	SZ	スワジランド
BE	ベルギー	GE	グルジア	MA	モロッコ	TD	チャード
BF	ブルキナ・ファソ	GH	ガーナ	MC	モナコ	TG	トーゴ
BG	ブルガリア	GM	ガンビア	MD	モルドヴァ	TJ	タジキスタン
BJ	ベナン	GN	ギニア	MG	マダガスカル	TM	トルクメニスタン
BR	ブラジル	GR	ギリシャ	MK	マケドニア旧ユーゴスラヴィア	TR	トルコ
BY	ベラルーシ	GW	ギニア・ビサウ		共和国	TT	トリニダード・トバゴ
CA	カナダ	HR	クロアチア	ML	マリ	TZ	タンザニア
CF	中央アフリカ	HU	ハンガリー	MN	モンゴル	UA	ウクライナ
CG	コンゴ	ID	インドネシア	MR	モリタニア	UG	ウガンダ
CH	スイス	IE	アイルランド	MW	マラウイ	US	米国
CI	コートジボワール	IL	イスラエル	MX	メキシコ	UZ	ウズベキスタン
CM	カメルーン	IN	インド	MZ	モザンビーク	VN	ヴェトナム
CN	中国	IS	アイスランド	NE	ニジェール	YU	ユーゴスラヴィア
CR	コスタ・リカ	IT	イタリア	NL	オランダ	ZA	南アフリカ共和国
CU	キューバ	JP	日本	NO	ノルウェー	ZW	ジンバブエ
CY	キプロス	KE	ケニア	NZ	ニュージーランド		
CZ	チェッコ	KG	キルギスタン	PL	ポーランド		
DE	ドイツ	KP	北朝鮮	PT	ポルトガル		
DK	デンマーク	KR	韓国	RO	ルーマニア		